

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국



(10) 국제공개번호

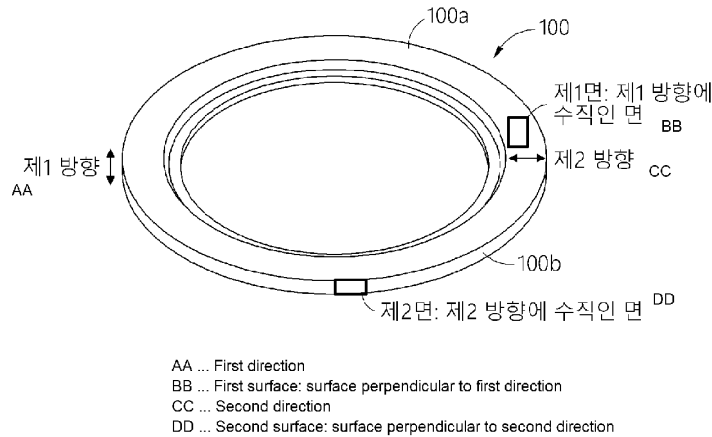
WO 2020/256411 A1

2020 년 12 월 24 일 (24.12.2020) WIPO | PCT

- (51) 국제특허분류: *H01L 21/67* (2006.01) *H01L 21/687* (2006.01)
H01J 37/32 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2020/007850
- (22) 국제출원일: 2020 년 6 월 17 일 (17.06.2020)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보: 10-2019-0074450 2019 년 6 월 21 일 (21.06.2019) KR
- (71) 출원인: 주식회사 티씨케이 (TOKAI CARBON KOREA CO., LTD) [KR/KR]; 17602 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71, Gyeonggi-do (KR).
- (72) 발명자: 이상철 (LEE, Sang Chul); 17602 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71, Gyeonggi-do (KR). 박영순 (PARK, Yeong Soon); 16814 경기도 용인시 수지구 신봉1로 112-2, 510동 501호, Gyeonggi-do (KR).
- (74) 대리인: 특허법인 무한 (MUHANN PATENT & LAW FIRM); 06144 서울시 강남구 언주로 560, 8층, Seoul (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI

(54) Title: SIC STRUCTURE FORMED BY CVD METHOD

(54) 발명의 명칭: CVD 방식으로 형성된 SIC 구조체



(57) Abstract: The present invention relates to a component for manufacturing a semiconductor manufactured by using a CVD method. A SiC structure formed by the CVD method according to one aspect of the present invention is used such that the SiC structure is exposed to plasma inside a chamber, wherein the SiC structure comprises a crystal grain structure in which the length in a first direction is longer than the length in a second direction when defining a direction perpendicular to the surface most exposed to the plasma as the first direction and a direction horizontal to the surface most exposed to the plasma as the second direction.

(57) 요약서: 본 발명은 CVD 방식을 이용하여 제조한 반도체 제조용 부품에 관한 것으로서, 본 발명의 일 측면에 따르는 CVD 방식으로 형성된 SiC 구조체는, 챔버 내부에서 플라즈마에 노출되도록 이용되는 SiC 구조체에 있어서, 플라즈마에 최대 노출되는 면에 수직한 방향을 제1 방향으로, 플라즈마에 최대 노출되는 면에 수평한 방향을 제2 방향으로 정의할 때, 상기 제1 방향 길이가 상기 제2 방향 길이보다 길게 형성된 결정립 구조를 포함하는 것이다.

[다음 쪽 계속]



WO 2020/256411 A1

(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))